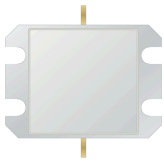
5700–7100 MHz GaN 내부 정합 전력 트랜지스터 — PSAT 51 dBm (대표값)

LCT-5700-7100-PS51T · 5700–7100 MHz · GaN 내부 정합 전력 트랜지스터.



RF 전기 특성표의 규격값: PSAT 51 dBm (대표값); 전력 이득 11 dB (대표값); PAE 45 % (대표값). RF 측정 조건: TA = +25 °C; VDS = 28 V; VGS ∈ [-3.2, -2.4] V; Pin = 40 dBm; D = 10%; PW = 100 µs.

CMW025B

게이트 바이어스를 먼저 인가한 다음 드레인 바이어스를 인가합니다. 끌 때는 드레인 바이어스를 먼저 제거합니다.

Vg: C = 10 µF

RF 특성

TA = +25 °C; VDS = 28 V; VGS ∈ [-3.2, -2.4] V; Pin = 40 dBm; D = 10%; PW = 100 µs

항목	기호	최솟값	일반값	최댓값	단위
동작 주파수	f	5700	-	7100	MHz
포화 출력 전력	-	50.5	51	-	dBm
전력 이득	-	10.5	11	-	dB
전력 부가 효율	-	40	45	-	%
전력 이득 평탄도	-	-	-	1.5	dB

DC 바이어스 및 전류

항목	기호	최솟값	일반값	최댓값	값	단위
드레인 동작 전압	-	-	-	-	28	V
게이트 동작 전압	-	-	-	-	[-3.2, -2.4]	V

한계값

한계값이며 정상 동작 설정값이 아닙니다.

항목	기호	최솟값	일반값	최댓값	단위
최대 드레인-소스 전압	-	-	-	32	V
게이트 바이어스 하한	-	-5	-	-	V
보관 온도	-	-65	-	150	°C
최대 입력 전력	-	-	-	42	dBm

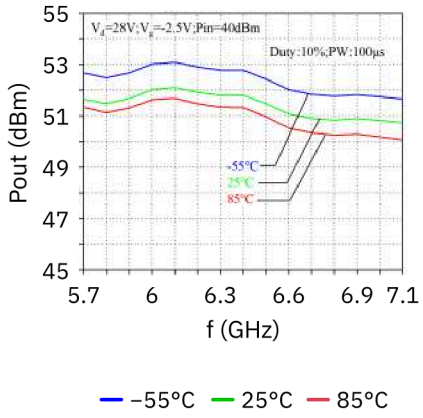
현재 발행 기록 · 1.5 · 2026-11-12. 제품 설명 또는 편집 내용을 업데이트했습니다. 대체하는 개정판 1.4.

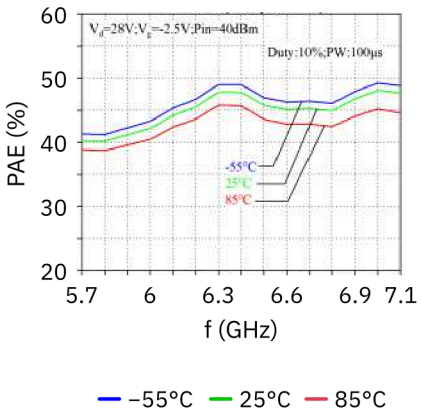
통합 설계 안내

CMW025B 게이트 바이어스를 먼저 인가한 다음 드레인 바이어스를 인가합니다. 끌 때는 드레인 바이어스를 먼저 제거합니다. Vg: C = 10 µF G: RF 입력 D: RF 출력 S: 소스 / 접지

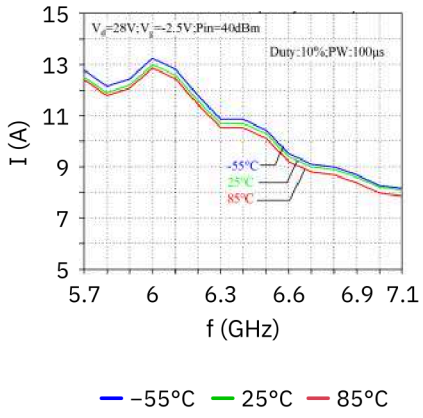
성능 특성 곡선

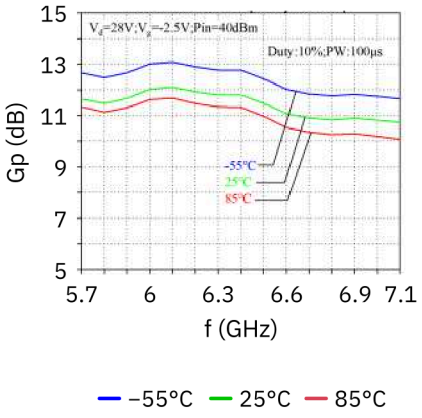
각 그림에 명시된 동작 조건과 함께 확인하십시오.



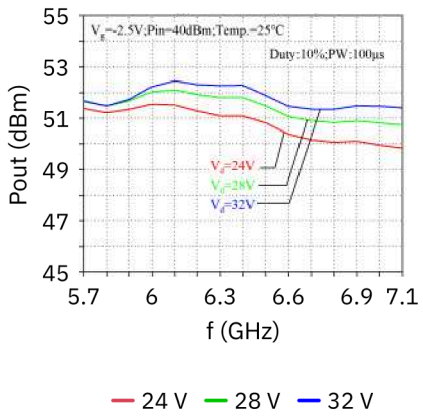


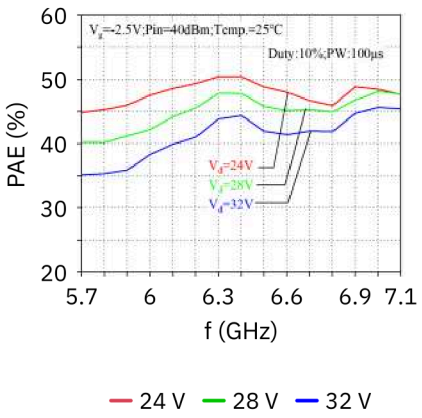
−55°C 25°C 85°C





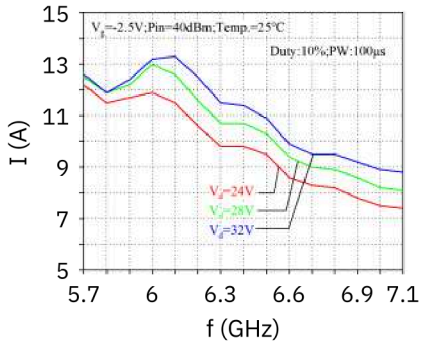
−55°C 25°C 85°C

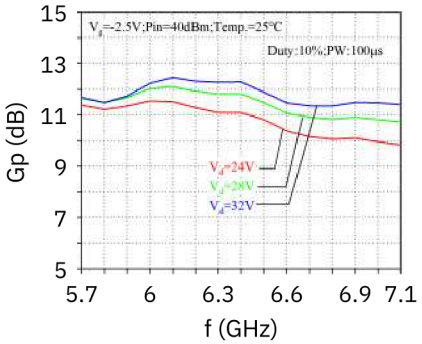




24 V 28 V 32 V

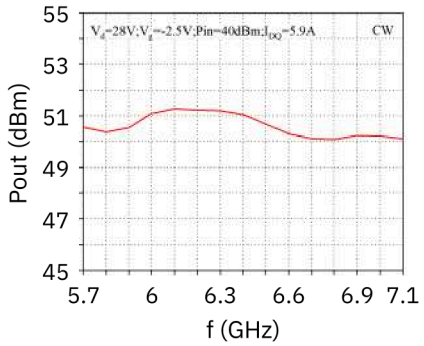
출력 전력; 전력 부가 효율; 드레인 전류; 전력 이득. 그래프 1–4: Vd = 28 V; Vg = −2.5 V; Pin = 40 dBm; D = 10%; PW = 100 μs; Temp = −55 / +25 / +85°C. 그래프 5–6: Vd = 24 / 28 / 32 V; Vg = −2.5 V; Pin = 40 dBm; Temp = +25°C; D = 10%; PW = 100 μs.

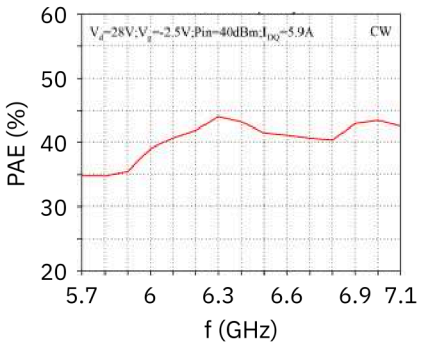


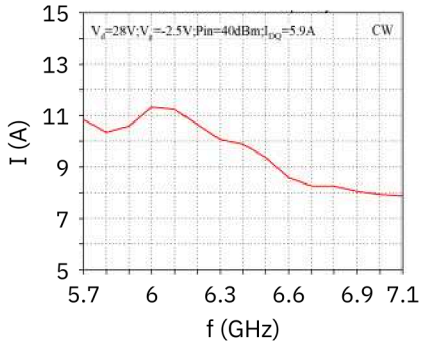


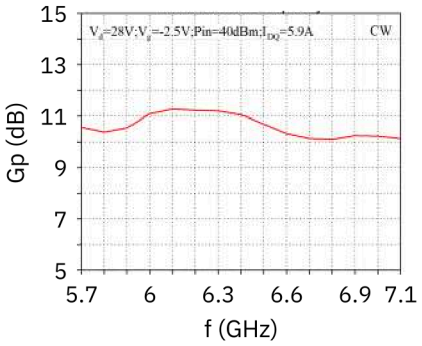
24 V 28 V 32 V

24 V 28 V 32 V

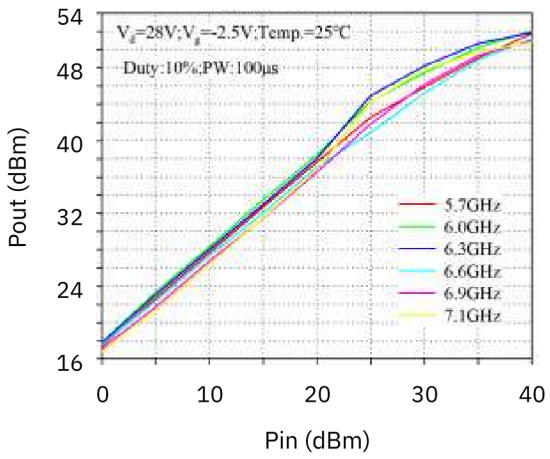


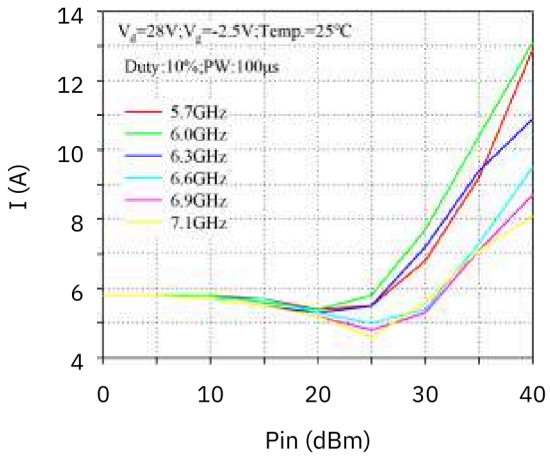






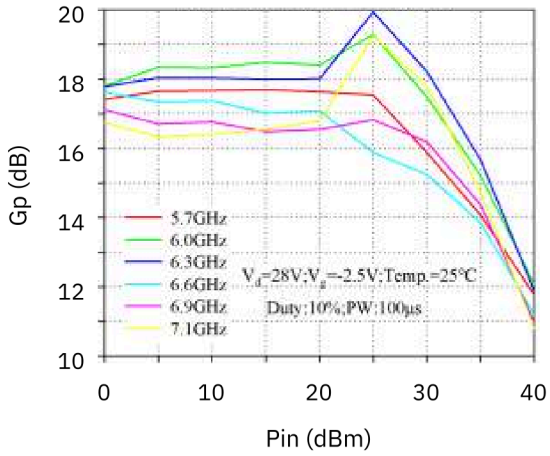
출력 전력; 전력 부가 효율; 드레인 전류; 전력 이득. 그래프 1–2: Id, Gp; Vd = 24 / 28 / 32 V; Vg = −2.5 V; Pin = 40 dBm; Temp = +25°C; D = 10%; PW = 100 μs. 그래프 3–6: Pout, PAE, Id, Gp; Vd = 28 V; Vg = −2.5 V; Pin = 40 dBm; IDQ = 5.9 A; CW.





5.7 GHz 6.3 GHz 6.9 GHz
6.0 GHz 6.6 GHz 7.1 GHz

5.7 GHz 6.3 GHz 6.9 GHz
6.0 GHz 6.6 GHz 7.1 GHz



5.7 GHz 6.3 GHz 6.9 GHz
6.0 GHz 6.6 GHz 7.1 GHz

출력 전력; 드레인 전류; 전력 이득. Vd = 28 V; Vg = −2.5 V; Temp = +25°C; D = 10%; PW = 100 µs; Pin = 0–40 dBm.

문서 안내

제품 업데이트에 따라 사양이 개정될 수 있습니다. 설계를 확정하기 전에 현재 문서 개정판과 제품별 요구 사항을 LCRF에 확인하십시오. 공급 구성은 승인된 견적서와 주문 문서에 따라 정의됩니다.